

Nuhiki

11-109417

\* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

DETAILED DESCRIPTION

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the liquid crystal display equipped with the transparency viewing area and the reflective viewing area.

[0002]

[Description of the Prior Art] The active matrix liquid crystal display in which the TFT (TFT) or the MIM element constituted by the amorphous silicon as a liquid crystal display with the gate wiring of every two or more which crosses mutually, and data wiring was formed on the substrate is known. There are a penetrated type liquid crystal display which uses a back light as the light source, and a reflected type liquid crystal display which reflects an external light and is used for a display in this active-matrix substrate. In such active matrix liquid crystal display, the penetrated type liquid crystal display and reflected type liquid crystal display of high numerical aperture structure which make a picture element electrode superimpose on gate wiring and data wiring through a layer insulation film are developed, using organic materials, such as photosensitive transparent acrylic resin, as a layer insulation film.

[0003] Drawing 8 (a) is the plan of the reflected type liquid crystal display of the high numerical aperture structure where the organic compound insulator was used as a layer insulation film, and drawing 8 (b) is the cross section showing the F-F cross section of drawing 8 (a). The active matrix liquid crystal display shown in drawing 8 is equipped with the gate wiring 1, the data wiring 2, a driver element 3, the drain electrode 4, the auxiliary capacity electrode 5, the gate insulator layer 6, the insulating substrate 7, a contact hole 8, the layer insulation film 9, the picture element electrode 10 for reflection, and the auxiliary capacity wiring 12.

[0004] It can consider as a penetrated type liquid crystal display by using as a transparent electrode the picture element electrode 10 for reflection of the active matrix liquid crystal display shown in drawing 8.

[0005] In order to reduce the capacity generated by making a picture element electrode superimpose on gate wiring and data wiring through the layer insulation film 9 as a material of the layer insulation film 9 used for this high numerical aperture structure, it is required that forming by the thickness of several micrometers is easy, that a dielectric constant should be small as compared with a silicon nitride etc., etc., and the organic compound insulator is used.

[0006] Moreover, although it is necessary to form a contact hole in the layer insulation film 9 in order to form this high numerical aperture structure and to take electric contact of the drain electrode 4 arranged in the lower layer of the layer insulation film 9, and the picture element electrode arranged in the upper layer of the layer insulation film 9 After applying a liquefied resin material to a substrate by the spin applying method by using photosensitive acrylic resin as a layer insulation film 9, Since it can expose at a FOTORISO process, patterning can be carried out by performing development by the alkaline solution and a contact hole can be formed, it is possible to perform membrane formation and patterning simultaneously.

[0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] The penetrated type liquid crystal display which uses the light from a back light for a display had much power consumption in order to use a back light, and when a dc-battery was used, it had the trouble that continuous duty time was short.

[0008] Moreover, although it had little power consumption since a back light was not used for a reflected type liquid crystal display, and continuous duty time had the advantage of being long, reflectivity was not enough, and there was a trouble of being hard to use it in a dark place.

[0009]

[Means for Solving the Problem] Two or more gate wiring with which this invention was prepared on the insulating substrate and this insulating substrate, The driver element prepared in the intersection of two or more data wiring which intersects this gate wiring, and this gate wiring and this data wiring, The active-matrix substrate which has the picture element electrode electrically connected to this driver element, In the active matrix liquid crystal display which has the liquid crystal layer which intervened between the opposite substrate in which the counterelectrode was formed, and the aforementioned active-matrix substrate and the aforementioned opposite substrate, and a back light The aforementioned picture element electrode is characterized by having a picture element electrode for reflection, and a picture element electrode for transparency. the transparency reflection which according to this invention uses as a reflected type liquid crystal display in a bright place, turns on a back light in a dark place and can be used as a penetrated type liquid crystal display -- formation of switchable active matrix liquid crystal display is attained

[0010] Moreover, this invention is characterized by connecting electrically the aforementioned picture element electrode for reflection, and the aforementioned picture element electrode for transparency. Since the picture element electrode for reflection and the picture element electrode for transparency are connected electrically, it is not necessary to form the wiring for inputting a driving signal separately, and according to this invention, the composition of an active-matrix substrate can be simplified.

[0011] Moreover, this invention is characterized by forming the aforementioned picture element electrode for reflection in the upper part of the aforementioned driver element. According to this invention, the picture element electrode for reflection is formed on a driver element, and it can prevent the light from the outside carrying out incidence to a driver element.

[0012] Moreover, this invention is characterized by making larger than the area of the portion which penetrates the light of a back light by the aforementioned picture element electrode for transparency area of the portion which reflects an external light by the aforementioned picture element electrode for reflection. Although according to this invention the picture element electrode for transparency does not contribute to the brightness of a panel when having switched off the back light, since the picture element electrode for reflection which reflects the light from the outside contributes to the brightness of a panel irrespective of lighting of a back light, and putting out lights, the time of the light of a back light putting out the light and brightness can stabilize the brightness of the display also to the time of a low by enlarging the area.

[0013] Moreover, this invention is characterized by preparing a micro lens between the aforementioned active-matrix substrate and the aforementioned back light. The brightness of display can be raised, even if it does not raise the brightness of the back light itself, since the light from the back light covered by the picture element electrode for reflection, gate wiring, etc. can be brought together in the picture element electrode for transparency according to this invention.

[0014] Moreover, this invention is characterized by having formed the layer insulation film which has a ramp or the concavo-convex section on the aforementioned drain electrode, and forming the aforementioned picture element electrode for reflection on this layer insulation film. Since a flare comes out in the direction in which the light from the outside is reflected by the picture element electrode for reflection according to this invention, an angle of visibility can be extended.

[0015] Moreover, this invention is characterized by forming the aforementioned picture element electrode for reflection in the same layer as the aforementioned gate wiring or the aforementioned data wiring. According to this invention, there is no need of establishing independently the process which forms the picture element electrode for reflection, and the number of processes and a manufacturing cost are not made to increase.

[0016] Moreover, this invention is characterized by connecting electrically gate wiring of the picture element which adjoined the aforementioned picture element electrode for reflection formed in the same layer as the aforementioned gate wiring. According to this invention, since it connects with gate wiring electrically and the picture element electrode for reflection is, stray capacity-ization can be prevented and auxiliary capacity can be formed between drain electrodes.

[0017] Moreover, this invention is characterized by inputting the same signal as the signal impressed to the aforementioned counterelectrode into the aforementioned picture element electrode for reflection formed in the same layer as the aforementioned gate wiring. Since the same signal as the signal impressed to a counterelectrode is inputted into the picture element electrode for reflection according to this invention, stray capacity-ization can be prevented.

[0018] Moreover, this invention is characterized by superimposing the aforementioned picture element electrode for reflection, the drain electrode, or the picture element electrode for transparency formed in the same layer as the aforementioned gate wiring, and forming auxiliary capacity. According to this invention, the auxiliary capacity of the voltage impressed to a picture element electrode can be formed using the picture element electrode for reflection.

[0019]

[Embodiments of the Invention]

(Operation gestalt 1) Drawing 1 (a) shows the plan of the active-matrix substrate of the operation gestalt 1 of this invention, and drawing 1 (b) shows the cross section of the A-A cross section of drawing 1 (a).

[0020] The active-matrix substrate is equipped with the gate wiring 1, the data wiring 2, a driver element 3, the drain electrode 4, the auxiliary capacity electrode 5, the gate insulator layer 6, the insulating substrate 7, the contact hole 8, the layer insulation film 9, the picture element electrode 10 for reflection, and the picture element electrode 11 for transparency. It connects as electrically as the drain electrode 4, and the auxiliary capacity electrode 5 is superimposed on the gate wiring 1 in order to connect the picture element electrode 11 for transparency, and the auxiliary capacity electrode 5.

[0021] This active-matrix substrate is equipped with the picture element electrode 10 for reflection, and the picture element electrode 11 for transparency into one picture element, and as shown in drawing 2, it forms picture element electrode 10 portion for reflection which reflects the light from the outside into one picture element, and picture element electrode 11 portion for transparency which penetrates the light of a back light.

[0022] Drawing 2 is the cross section showing the liquid crystal display using the active-matrix substrate shown in drawing 1, and has the data wiring 2, the drain electrode 4, the gate insulator layer 6, the insulating substrate 7, the layer insulation film 9, the picture element electrode 10 for reflection, the picture element electrode 11 for transparency, the light-filter layer 13, a counterelectrode 14, the liquid crystal layer 15, the orientation film 16, the polarizing plate 17, and the back light 18.

[0023] It is more desirable to make area of picture element electrode 10 portion for reflection larger than picture element electrode 11 portion for transparency, in order that picture element electrode 10 portion for reflection which reflects the light from the outside may contribute to the brightness of a panel irrespective of lighting of a back light and putting out lights, although picture element electrode 11 portion for transparency which penetrates the light of a back light 18 does not

contribute to the brightness of a panel when having switched off the back light.

[0024] Although the picture element electrode 10 for reflection was formed on the picture element electrode 11 for transparency and it has connected electrically with this operation gestalt in order to input the same signal as the picture element electrode 10 for reflection, and the picture element electrode 11 for transparency, the picture element electrode 10 for reflection and the picture element electrode 11 for transparency may not be connected electrically, but another signal may be inputted into each, and a separate display may be performed.

[0025] The light from the back light 18 by which incidence is carried out to the field in which the picture element electrode 10 for reflection was formed in the liquid crystal display of drawing 2. Since it cannot use as a display light, as shown in the cross section of the liquid crystal display shown in drawing 3, a micro lens 19 and the micro-lens protective layer 20 are formed between a back light 18 and a liquid crystal display panel. Make the field of the picture element electrode 11 for transparency in which the picture element electrode 10 for reflection is not formed of a micro lens 19 condense back light light, the amount of the light which penetrates the picture element electrode 11 for transparency is made to increase, and the brightness of a display can be raised.

[0026] Drawing 4 (a) shows the plan of the active-matrix substrate of other examples of this operation gestalt, and drawing 4 (b) shows the cross section of the B-B cross section of drawing 4 (a), and may be reversing the field of the picture element electrode 10 for reflection, and the picture element electrode 11 for transparency to drawing 1, and it may change suitably the surface ratio of the picture element electrode 10 for reflection, and the picture element electrode 11 for transparency.

[0027] Since the direction of the active-matrix substrate of drawing 1 forms the picture element electrode 10 for reflection on a driver element 3, and it can prevent the light from the outside carrying out incidence to a driver element 3 and the picture element electrode 11 for transparency is arranged in the center of a picture element when the active-matrix substrate of drawing 1 is compared with the active-matrix substrate of drawing 4, it is easy to form the micro lens 19 for condensing.

[0028] In this invention, although the way which gathers a numerical aperture as much as possible adopted high numerical aperture \*\*\*\* which intervened the layer insulation film 9 which consists of an organic compound insulator between a picture element electrode, the gate wiring 1, and the source wiring 3 with \*\*\*\*\* and this operation gestalt in order to form the portion which reflects light into one picture element, and the portion to penetrate, you may use other structures.

[0029] (Operation gestalt 2) Drawing 5 (a) shows the plan of the active-matrix substrate of the operation gestalt 2, and drawing 5 (b) shows the cross section of the C-C cross section of drawing 5 (a).

[0030] The active matrix liquid crystal display of the operation gestalt 2 forms the picture element electrode 10 for reflection on the layer insulation film 9 in which a ramp or the concavo-convex section was formed, and since a flare comes out in the direction in which the light from the outside is reflected by the picture element electrode 10 for reflection, it can extend an angle of visibility.

[0031] Moreover, if the layer insulation film 9 is the thickest on the gate wiring 1 or the data wiring 2, and a ramp or the concavo-convex section is formed so that it may not form on the drain electrode 4, there is no need of forming the contact hole for taking electric contact of the drain electrode 4 and the picture element electrode 10, and since the orientation disorder of the liquid crystal molecule generated for the steep level difference in the contact hole section can be prevented, a large numerical aperture can be taken.

[0032] The drain electrode 4 serves as the picture element electrode for transparency, and is a transparent electrode which consists of ITO etc.

[0033] Moreover, it is necessary to hold down the tilt angle of the ramp of the layer insulation film 9, or the concavo-convex pitch of the concavo-convex section to the angle which is a grade which can perform rubbing processing enough after forming an orientation film, and conditions [ \*\*\*\*\* ] are used for it to each rubbing conditions and a liquid crystal molecule.

[0034] A micro lens can be prepared in drain electrode 4 portion which served as the picture element electrode for transparency also in this operation gestalt, and the brightness at the time of back light lighting can be increased.

[0035] (Operation gestalt 3) Drawing 6 (a) shows the plan of the active-matrix substrate of the operation gestalt 3, and drawing 6 (b) shows the cross section of the D-D cross section of drawing 6 (a).

[0036] In this operation gestalt, the picture element electrode 10 for reflection is formed in the same layer as the gate wiring 1 at the same process. If it does in this way, there will be no need of establishing independently the process which forms the picture element electrode 10 for reflection, and the number of processes and a manufacturing cost will not be made to increase.

[0037] In the case of this operation gestalt, it does not connect with the drain electrode 4 of a driver element 3, but the picture element electrode 10 for reflection is used to reflect the light from the outside, and the picture element electrode 11 for transparency performs a role of an electrode for driving liquid crystal.

[0038] Namely, control of the permeability of light which the picture element electrode 10 for reflection reflected is performed by controlling a liquid crystal layer by voltage of the picture element electrode 11 for transparency.

[0039] Under the present circumstances, if no signals are inputted into the picture element electrode 10 for reflection, since stray capacity will occur between the drain electrode 4 or the picture element electrode 11 for transparency, it is desirable to input into the picture element electrode 10 for reflection a signal which does not have a bad influence on a display, by connecting with the adjoining gate wiring 1, stray capacity-ization can be prevented and auxiliary capacity can be formed between the drain electrodes 4.

[0040] The brightness at the time of back light lighting can be increased by condensing to the picture element electrode for transparency by the micro lens also in this operation gestalt.

[0041] It is more desirable for this invention to also gather a numerical aperture as much as possible, in order to form the portion which reflects light into one picture element, and the portion to penetrate.

[0042] So, although the high numerical aperture structure which used the organic compound insulator for the layer insulation film was adopted as composition of this operation gestalt, you may use other structures.

[0043] (Operation gestalt 4) The plan of the active-matrix substrate of the operation gestalt 4 is shown in drawing 7 (a), and the cross section of the E-E cross section of drawing 7 (a) is shown in drawing 7 (b).

[0044] This operation gestalt forms the picture element electrode 10 for reflection in the same layer as the data wiring 2.

[0045] If it does in this way, in case the data wiring 2 will be formed, the picture element electrode 10 for reflection can be formed, and the number of processes and a manufacturing cost are not made to increase.

[0046] Since the high numerical aperture structure which minded the layer insulation film 9 also by the case of this operation gestalt is adopted, like the operation gestalt 3, it is used only for the picture element electrode 10 for reflection reflecting the light from the outside, and only the picture element electrode 11 for transparency performs a role of an electrode for driving a liquid crystal molecule.

[0047] That this operation gestalt differs from the operation gestalt 3 here is a point currently formed in the form which the drain electrode 4 and the picture element electrode for reflection connected electrically, and in using the drain electrode 4 as a picture element electrode for transparency, without forming the layer insulation film 9, the picture element electrode 10 for reflection also contributes to the drive of a liquid crystal molecule.

[0048] The brightness at the time of back light lighting can be increased by condensing to the picture element electrode 11 for transparency by the micro lens also in this operation gestalt.

[0049] It is more desirable to raise a numerical aperture also with this operation gestalt as much as possible, in order to form the portion which reflects light into one picture element, and the portion to penetrate. So, although the high numerical aperture structure which used the organic compound insulator for the layer insulation film was adopted as composition of this operation gestalt, you may use other composition.

[0050]

[Effect of the Invention] According to this invention, the active matrix liquid crystal display which can change a reflected type and a penetrated type can be formed. Though sufficient brightness is taken out with any operating conditions when a user changes reflection to transparency according to an operating condition by this, a liquid crystal display that there is little power consumption and usable for a long time is realizable.

[0051] moreover, the transparency reflection which uses as a reflected type liquid crystal display in a bright place, turns on a back light in a dark place and can be used as a penetrated type liquid crystal display -- formation of switchable active matrix liquid crystal display is attained Moreover, since the picture element electrode for reflection and the picture element electrode for transparency are connected electrically, it is not necessary to form the wiring for inputting a driving signal separately, and the composition of an active-matrix substrate can be simplified.

[0052] Moreover, the picture element electrode for reflection is formed on a driver element, and it can prevent the light from the outside carrying out incidence to a driver element. Moreover, although the picture element electrode for transparency does not contribute to the brightness of a panel when having switched off the back light, the picture element electrode for reflection which reflects the light from the outside can stabilize the brightness of a display by enlarging the area, when the light of a back light puts out the light, or when brightness is low, in order to contribute to the brightness of a panel irrespective of lighting of a back light, and putting out lights.

[0053] Moreover, the brightness of display can be raised, even if it does not raise the brightness of the back light itself, since the light from the back light covered by the picture element electrode for reflection, gate wiring, etc. can be brought together in the picture element electrode for transparency. Moreover, since a flare comes out in the direction in which the light from the outside is reflected by the picture element electrode for reflection, an angle of visibility can be extended.

[0054] Moreover, there is no need of establishing independently the process which forms the picture element electrode for reflection, and the number of processes and a manufacturing cost are not made to increase. Moreover, since it connects with gate wiring electrically and the picture element electrode for reflection is, stray capacity-ization can be prevented and auxiliary capacity can be formed between drain electrodes.

[0055] Moreover, since the same signal as the signal impressed to a counterelectrode is inputted into the picture element electrode for reflection, stray capacity-ization can be prevented. Moreover, the auxiliary capacity of the voltage impressed to a picture element electrode can be formed using the picture element electrode for reflection.

---

[Translation done.]

Nishiki

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-109417

(43) 公開日 平成11年(1999) 4月23日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

G 0 2 F

1/136

1/1335

1/1341

識別記号

5 0 0

5 2 0

F I

G 0 2 F

1/136

1/1335

1/1341

5 0 0

5 2 0

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号

特願平9-274327

(22) 出願日

平成9年(1997)10月7日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 錦 博彦

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

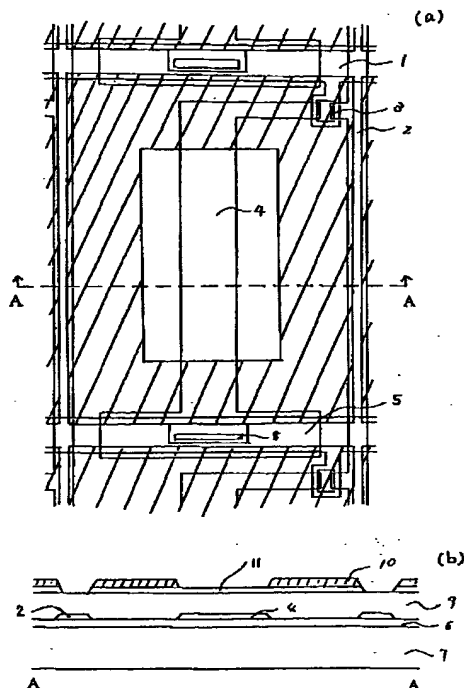
(74) 代理人 弁理士 梅田 勝

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 液晶表示装置において、明るい場所では消費電力が少なく、暗い場所で十分な表示輝度を有する表示状態を得ることとする。

【解決手段】 このアクティブマトリクス基板は一つの絵素の中に反射用絵素電極10と透過用絵素電極11を備えており、図2に示すように、一つの絵素の中に外部からの光を反射する反射用絵素電極10部分とバックライトの光を透過する透過用絵素電極11部分を形成している。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性基板と、該絶縁性基板上に設けられた複数のゲート配線と、該ゲート配線と交差する複数のデータ配線と、該ゲート配線と該データ配線との交差部に設けられた駆動素子と、該駆動素子に電氣的に接続された絵素電極とを有するアクティブマトリクス基板と、対向電極が形成された対向基板と、前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に介在された液晶層と、バックライトとを有するアクティブマトリクス型液晶表示装置において、

前記絵素電極は、反射用絵素電極と透過用絵素電極とを有することを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項2】 前記反射用絵素電極と前記透過用絵素電極を電氣的に接続することを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項3】 前記駆動素子の上部に前記反射用絵素電極を形成することを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項4】 前記反射用絵素電極によって外部の光を反射する部分の面積を、前記透過用絵素電極によってバックライトの光を透過する部分の面積よりも大きくすることを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項5】 前記アクティブマトリクス基板と前記バックライトの間にマイクロレンズを設けたことを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項6】 前記ドレイン電極上に傾斜部又は凹凸部をもつ層間絶縁膜が形成され、該層間絶縁膜上に前記反射用絵素電極が形成されたことを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項7】 前記ゲート配線又は前記データ配線と同じ層に前記反射用絵素電極を形成することを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項8】 前記ゲート配線と同じ層に形成された前記反射用絵素電極と隣接した絵素のゲート配線を電氣的に接続することを特徴とする請求項7に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項9】 前記ゲート配線と同じ層に形成された前記反射用絵素電極に前記対向電極に印加される信号と同じ信号を入力することを特徴とする請求項7に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項10】 前記ゲート配線と同じ層に形成された前記反射用絵素電極とドレイン電極又は透過用絵素電極を重畳して補助容量を形成することを特徴とする請求項7乃至請求項9に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、透過表示領域と反射表示領域を備えた液晶表示装置に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】液晶表示装置としては、互いに交差する複数本ずつのゲート配線とデータ配線とともに、アモルファスSiにより構成した薄膜トランジスタ(TFT)或いはMIM素子を基板上に形成したアクティブマトリクス型液晶表示装置が知られている。このアクティブマトリクス基板には、光源としてバックライトを利用する透過型液晶表示装置と、外部の光を反射して表示に利用する反射型液晶表示装置がある。これらのアクティブマトリクス型液晶表示装置において、感光性透明アクリル樹脂などの有機材料を層間絶縁膜として用い、ゲート配線及びデータ配線に絵素電極を層間絶縁膜を介して重畳させる高開口率構造の透過型液晶表示装置や反射型液晶表示装置が開発されている。

【0003】図8(a)は、層間絶縁膜として有機絶縁膜を用いた高開口率構造の反射型液晶表示装置の平面図であり、図8(b)は、図8(a)のF-F断面を示す断面図である。図8に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置は、ゲート配線1、データ配線2、駆動素子3、ドレイン電極4、補助容量電極5、ゲート絶縁膜6、絶縁性基板7、コンタクトホール8、層間絶縁膜9、反射用絵素電極10、補助容量配線12とを備えている。

【0004】図8に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置の反射用絵素電極10を透明の電極とすることにより透過型液晶表示装置とすることができる。

【0005】この高開口率構造に使用する層間絶縁膜9の材料としては、層間絶縁膜9を介して絵素電極をゲート配線及びデータ配線に重畳させることにより発生する容量を低減するために、数 $\mu\text{m}$ の厚さで形成することが容易であること、誘電率が窒化シリコン等と比較して小さいこと等が要求されており、有機絶縁膜が用いられている。

【0006】また、この高開口率構造を形成する為には、層間絶縁膜9の下層に配設されたドレイン電極4と層間絶縁膜9の上層に配設された絵素電極の電氣的接触を取るために、層間絶縁膜9にコンタクトホールを形成する必要があるが、感光性アクリル樹脂を層間絶縁膜9として用いることにより、液状の樹脂材料をスピン塗布法により基板上に塗布した後、フォトリソ工程にて露光し、アルカリ性溶液による現像を行うことによりパターンニングし、コンタクトホールを形成することができるので、成膜とパターンニングを同時に行うことが可能である。

## 【0007】

【発明が解決しようとする課題】バックライトからの光を表示に利用する透過型液晶表示装置はバックライトを

使用するため消費電力が多く、バッテリーを使用する場合、連続使用時間が短いという問題点があった。

【0008】また反射型液晶表示装置は、バックライトを使用しないため消費電力が少なく、連続使用時間が長いという長所を持っているが、反射強度が十分ではなく、暗いところでは使用しにくいという問題点があった。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は、絶縁性基板と、該絶縁性基板上に設けられた複数のゲート配線と、該ゲート配線と交差する複数のデータ配線と、該ゲート配線と該データ配線との交差部に設けられた駆動素子と、該駆動素子に電気的に接続された絵素電極とを有するアクティブマトリクス基板と、対向電極が形成された対向基板と、前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に介在された液晶層と、バックライトとを有するアクティブマトリクス型液晶表示装置において、前記絵素電極は、反射用絵素電極と透過用絵素電極とを有することを特徴とする。本発明によれば、明るいところでは反射型液晶表示装置として使用し、暗い所ではバックライトを点灯し透過型液晶表示装置として使用できる透過反射切り替え可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置の形成が可能となる。

【0010】また、本発明は、前記反射用絵素電極と前記透過用絵素電極を電気的に接続することを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極と透過用絵素電極とを電気的に接続しているため別々に駆動信号を入力するための配線を設ける必要がなく、アクティブマトリクス基板の構成を簡略化できる。

【0011】また、本発明は、前記駆動素子の上部に前記反射用絵素電極を形成することを特徴とする。本発明によれば、駆動素子の上部に反射用絵素電極を形成しており、外部からの光が駆動素子に入射することを防ぐことができる。

【0012】また、本発明は、前記反射用絵素電極によって外部の光を反射する部分の面積を、前記透過用絵素電極によってバックライトの光を透過する部分の面積よりも大きくすることを特徴とする。本発明によれば、透過用絵素電極は、バックライトを消灯しているときはパネルの輝度に寄与しないが、外部からの光を反射する反射用絵素電極はバックライトの点灯、消灯にかかわらずパネルの輝度に寄与するため、その面積を大きくすることにより、バックライトの光が消灯したときや輝度が低いときにも表示の輝度を安定させることができる。

【0013】また、本発明は、前記アクティブマトリクス基板と前記バックライトの間にマイクロレンズを設けたことを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極やゲート配線等により遮蔽されるバックライトからの光を透過用絵素電極に集めることができるため、バックライト自体の輝度を高めなくても、表示装置の輝度を高め

ることができる。

【0014】また、本発明は前記ドレイン電極上に傾斜部又は凹凸部をもつ層間絶縁膜が形成され、該層間絶縁膜上に前記反射用絵素電極が形成されたことを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極によって外部からの光が反射される方向に拡がりが出るため、視野角を広げることができる。

【0015】また、本発明は、前記ゲート配線又は前記データ配線と同じ層に前記反射用絵素電極を形成することを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極を形成する工程を別に設ける必要が無く、工程数及び製造コストを増加させることが無い。

【0016】また、本発明は、前記ゲート配線と同じ層に形成された前記反射用絵素電極と隣接した絵素のゲート配線を電気的に接続することを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極がゲート配線と電気的に接続されるため、浮遊容量化を防ぐことができ、ドレイン電極との間に補助容量を形成することができる。

【0017】また、本発明は、前記ゲート配線と同じ層に形成された前記反射用絵素電極に前記対向電極に印加される信号と同じ信号を入力することを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極に対向電極に印加される信号と同じ信号が入力されるため、浮遊容量化を防ぐことができる。

【0018】また、本発明は、前記ゲート配線と同じ層に形成された前記反射用絵素電極とドレイン電極又は透過用絵素電極を重ねて補助容量を形成することを特徴とする。本発明によれば、絵素電極に印加される電圧の補助容量を反射用絵素電極を利用して形成することができる。

【0019】

【発明の実施の形態】

（実施形態1）図1（a）は本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図1（b）は図1（a）のA-A断面の断面図を示す。

【0020】アクティブマトリクス基板は、ゲート配線1、データ配線2、駆動素子3、ドレイン電極4、補助容量電極5、ゲート絶縁膜6、絶縁性基板7、コンタクトホール8、層間絶縁膜9、反射用絵素電極10と透過用絵素電極11を備えている。補助容量電極5は、ドレイン電極4と電気的に接続されており、ゲート絶縁膜6を介してゲート配線1と重畳し補助容量を形成している。コンタクトホール8は、透過用絵素電極11と補助容量電極5を接続するために層間絶縁膜9に設けられている。

【0021】このアクティブマトリクス基板は一つの絵素の中に反射用絵素電極10と透過用絵素電極11を備えており、図2に示すように、一つの絵素の中に外部からの光を反射する反射用絵素電極10部分とバックライトの光を透過する透過用絵素電極11部分を形成してい

る。

【0022】図2は、図1に示すアクティブマトリクス基板を用いた液晶表示装置を示す断面図であり、データ配線2、ドレイン電極4、ゲート絶縁膜6、絶縁性基板7、層間絶縁膜9、反射用絵素電極10、透過用絵素電極11、カラーフィルター層13、対向電極14、液晶層15、配向膜16、偏光板17、バックライト18を有している。

【0023】バックライト18の光を透過する透過用絵素電極11部分は、バックライトを消灯しているときはパネルの輝度に寄与しないが、外部からの光を反射する反射用絵素電極10部分はバックライトの点灯、消灯にかかわらずパネルの輝度に寄与するため、透過用絵素電極11部分より反射用絵素電極10部分の面積を大きくするほうが望ましい。

【0024】本実施形態では反射用絵素電極10と透過用絵素電極11に同じ信号を入力するために反射用絵素電極10を透過用絵素電極11の上に形成して電氣的に接続しているが、反射用絵素電極10と透過用絵素電極11を電氣的に接続せず、別の信号をそれぞれに入力し別々の表示を行ってもよい。

【0025】図2の液晶表示装置では反射用絵素電極10が形成された領域に入射されるバックライト18からの光は、表示光として利用できないため、図3に示す液晶表示装置の断面図のようにバックライト18と液晶表示パネルの間にマイクロレンズ19とマイクロレンズ保護層20を形成し、マイクロレンズ19により反射用絵素電極10が形成されていない透過用絵素電極11の領域にバックライト光を集光させ、透過用絵素電極11を透過する光の量を増加させ表示の輝度を高めることができる。

【0026】図4(a)は本実施形態の他の例のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図4(b)は図4(a)のB-B断面の断面図を示しており、図1に対して反射用絵素電極10と透過用絵素電極11の領域を逆転させており、反射用絵素電極10と透過用絵素電極11の面積比は適宜変更してもよい。

【0027】図1のアクティブマトリクス基板と図4のアクティブマトリクス基板を比べた場合、図1のアクティブマトリクス基板の方が、駆動素子3の上に反射用絵素電極10を形成しており、外部からの光が駆動素子3に入射することを防ぐことができ、また、透過用絵素電極11が絵素の中央に配設されているため集光用のマイクロレンズ19を形成しやすい。

【0028】本発明では、一つの絵素の中に光を反射する部分と透過する部分を形成するために、できるだけ開口率を上げるほうが望ましく、本実施形態では、絵素電極とゲート配線1及びソース配線3との間に有機絶縁膜からなる層間絶縁膜9を介在した高開口率溝造を採用したが、他の構造を用いてもよい。

【0029】(実施形態2)図5(a)は実施形態2のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図5(b)は図5(a)のC-C断面の断面図を示す。

【0030】実施形態2のアクティブマトリクス型液晶表示装置は、傾斜部又は凹凸部を形成した層間絶縁膜9上に反射用絵素電極10を形成しており、反射用絵素電極10によって外部からの光が反射される方向に拡がりが出るため、視野角を広げることができる。

【0031】また層間絶縁膜9は、ゲート配線1やデータ配線2上で最も厚く、ドレイン電極4上には形成しないように傾斜部又は凹凸部を形成すると、ドレイン電極4と絵素電極10の電氣的接触を取るためのコンタクトホールを形成する必要が無く、コンタクトホール部での急峻な段差のために発生していた液晶分子の配向乱れを防ぐことができるため、開口率を大きく取れる。

【0032】ドレイン電極4は透過用絵素電極を兼ねており、ITO等からなる透明な電極である。

【0033】また層間絶縁膜9の傾斜部の傾斜角又は凹凸部の凹凸ピッチは、配向膜を形成した上でラビング処理が十分行える程度の角度に抑える必要があり、各々のラビング条件及び液晶分子に対して最適化条件を用いる。

【0034】本実施形態においても透過用絵素電極を兼ねたドレイン電極4部分にマイクロレンズを設け、バックライト点灯時の輝度を増すことができる。

【0035】(実施形態3)図6(a)は実施形態3のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図6(b)は図6(a)のD-D断面の断面図を示す。

【0036】本実施形態において、反射用絵素電極10はゲート配線1と同じ層に同一工程で形成する。このようにすれば、反射用絵素電極10を形成する工程を別に設ける必要が無く、工程数及び製造コストを増加させることが無い。

【0037】本実施形態の場合、反射用絵素電極10は、駆動素子3のドレイン電極4と接続されておらず、外部からの光を反射することのみに使われており、液晶を駆動するための電極としての役割は透過用絵素電極11が行う。

【0038】即ち、反射用絵素電極10が反射した光の透過率の制御は、透過用絵素電極11の電圧によって液晶層を制御して行う。

【0039】この際、反射用絵素電極10に何も信号を入力していないと、ドレイン電極4若しくは透過用絵素電極11との間に浮遊容量が発生するため、反射用絵素電極10には表示に悪影響を与えないような信号を入力することが望ましく、隣接したゲート配線1と接続することにより、浮遊容量化を防ぎ、ドレイン電極4との間に補助容量を形成することができる。

【0040】本実施形態においてもマイクロレンズにより透過用絵素電極に集光することによりバックライト点



灯時の輝度を増すことができる。

【0041】本発明でも、一つの絵素の中に光を反射する部分と透過する部分を形成するためにできるだけ開口率を上げるほうが望ましい。

【0042】それ故本実施形態の構成としては、有機絶縁膜を層間絶縁膜に使用した高開口率構造を採用したが、この他の構造を用いてもよい。

【0043】(実施形態4)図7(a)には実施形態4のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図7(b)には図7(a)のE-E断面の断面図を示す。

【0044】本実施形態は反射用絵素電極10をデータ配線2と同じ層に形成している。

【0045】このようにすれば、データ配線2を形成する際に反射用絵素電極10を形成することができ、工程数及び製造コストを増加させることが無い。

【0046】本実施形態の場合でも層間絶縁膜9を介した高開口率構造を採用しているため、実施形態3と同様に反射用絵素電極10は外部からの光を反射することのみに使われており、液晶分子を駆動するための電極としての役割は透過用絵素電極11のみが行う。

【0047】ここで本実施形態が実施形態3と異なるのは、ドレイン電極4と反射用絵素電極が電氣的に接続した形で形成されている点であり、層間絶縁膜9を形成せずにドレイン電極4を透過用絵素電極として用いる場合には、反射用絵素電極10も液晶分子の駆動に寄与する。

【0048】本実施形態においてもマイクロレンズにより透過用絵素電極11に集光することによりバックライト点灯時の輝度を増すことができる。

【0049】本実施形態でも、一つの絵素の中に光を反射する部分と透過する部分を形成するためにできるだけ開口率を上げるほうが望ましい。それ故本実施形態の構成としては、有機絶縁膜を層間絶縁膜に使用した高開口率構造を採用したが、他の構成を用いてもよい。

【0050】

【発明の効果】本発明によると反射型と透過型の切り替えが可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置を形成できる。これにより使用者が使用状況に合わせて透過と反射を切り替えることにより、どのような使用状況でも十分な輝度を出しながらも、消費電力の少なく、長時間使用可能な液晶表示装置を実現できる。

【0051】また、明るいところでは反射型液晶表示装置として使用し、暗いところではバックライトを点灯し透過型液晶表示装置として使用できる透過反射切り替え可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置の形成が可能となる。また、反射用絵素電極と透過用絵素電極とを電氣的に接続しているため別々に駆動信号を入力するための配線を設ける必要がなく、アクティブマトリクス基板の構成を簡略化できる。

【0052】また、駆動素子の上に反射用絵素電極を形

成しており、外部からの光が駆動素子に入射することを防ぐことができる。また、透過用絵素電極は、バックライトを消灯しているときはパネルの輝度に寄与しないが、外部からの光を反射する反射用絵素電極はバックライトの点灯、消灯にかかわらずパネルの輝度に寄与するため、その面積を大きくすることにより、バックライトの光が消灯したときや輝度が低いときにも表示の輝度を安定させることができる。

【0053】また、反射用絵素電極やゲート配線等により遮蔽されるバックライトからの光を透過用絵素電極に集めることができるため、バックライト自体の輝度を高めなくても、表示装置の輝度を高めることができる。また、反射用絵素電極によって外部からの光が反射される方向に拡がりが出るため、視野角を広げることができる。

【0054】また、反射用絵素電極を形成する工程を別に設ける必要が無く、工程数及び製造コストを増加させることが無い。また、反射用絵素電極がゲート配線と電氣的に接続されているため、浮遊容量化を防ぐことができ、ドレイン電極との間に補助容量を形成することができる。

【0055】また、反射用絵素電極に対向電極に印加される信号と同じ信号が入力されるため、浮遊容量化を防ぐことができる。また、絵素電極に印加される電圧の補助容量を反射用絵素電極を利用して形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基板を示す平面図及び断面図である。

【図2】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基板を示す断面図である。

【図3】本発明のマイクロレンズを備えたアクティブマトリクス基板を示す断面図である。

【図4】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基板の他の例を示す平面図及び断面図である。

【図5】本発明の実施形態2のアクティブマトリクス基板を示す平面図及び断面図である。

【図6】本発明の実施形態3のアクティブマトリクス基板を示す平面図及び断面図である。

【図7】本発明の実施形態4のアクティブマトリクス基板を示す平面図及び断面図である。

【図8】従来の液晶表示装置を示す断面図である。

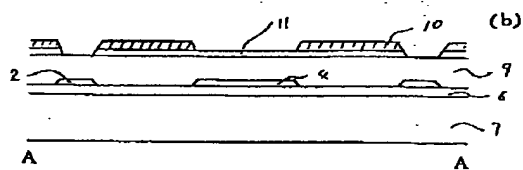
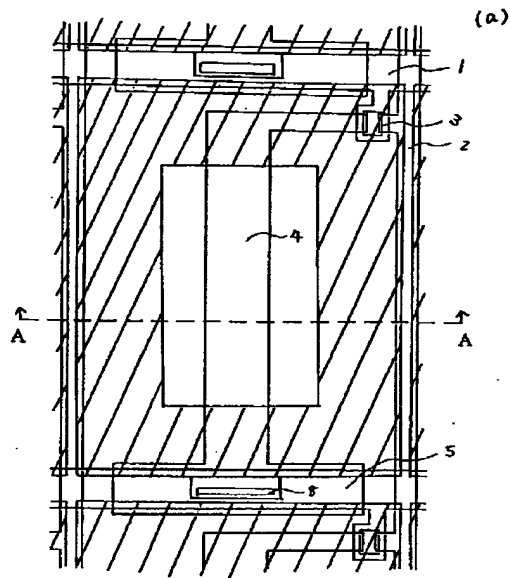
【符号の説明】

- |   |        |
|---|--------|
| 1 | ゲート配線  |
| 2 | データ配線  |
| 3 | 駆動素子   |
| 4 | ドレイン電極 |
| 5 | 補助容量電極 |
| 6 | ゲート絶縁膜 |
| 7 | 絶縁性基板  |

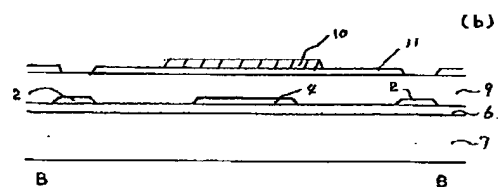
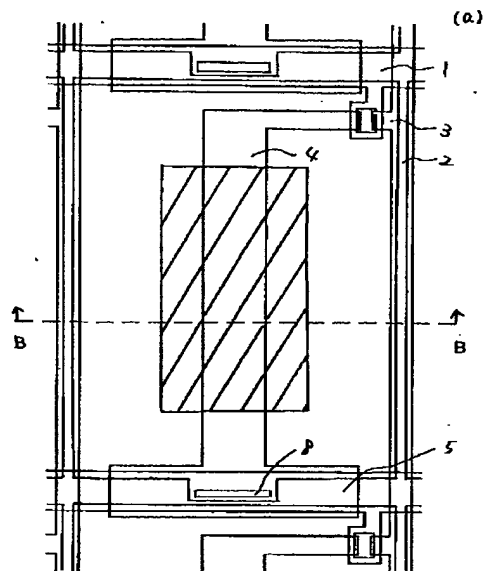
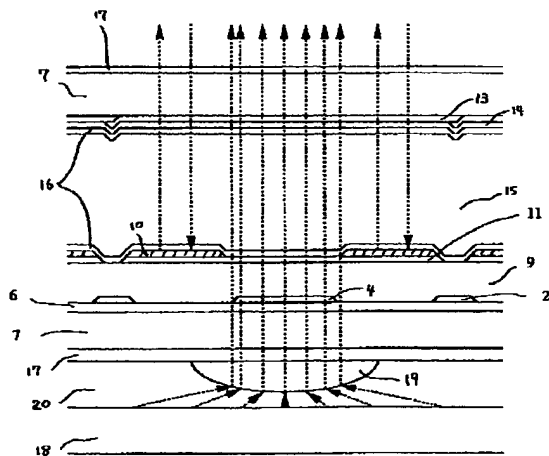
- 9  
8    コンタクトホール  
9    層間絶縁膜  
10   反射用絵素電極  
11   透過用絵素電極  
12   補助容量配線  
13   カラーフィルター層  
14   対向電極

- 10  
15   液晶層  
16   配向膜  
17   偏光板  
18   バックライト  
19   マイクロレンズ  
20   マイクロレンズ保護層

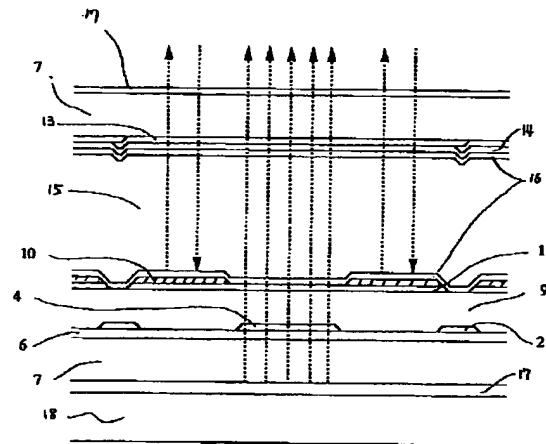
【図1】



【図3】

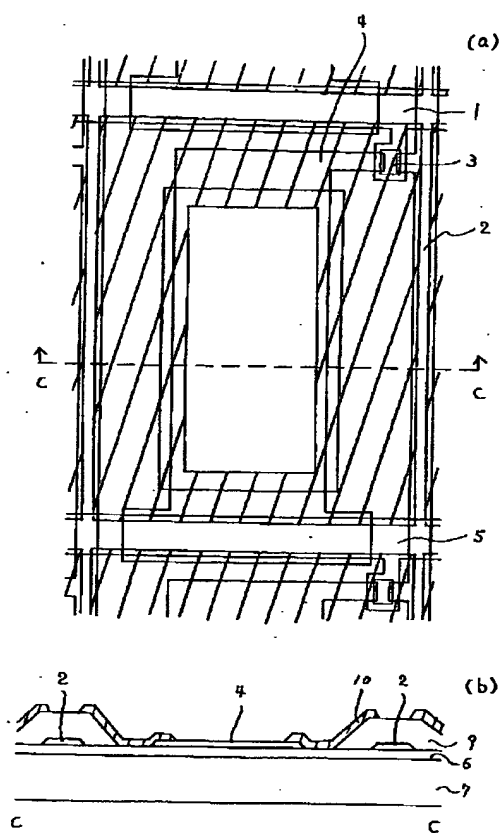


【図2】

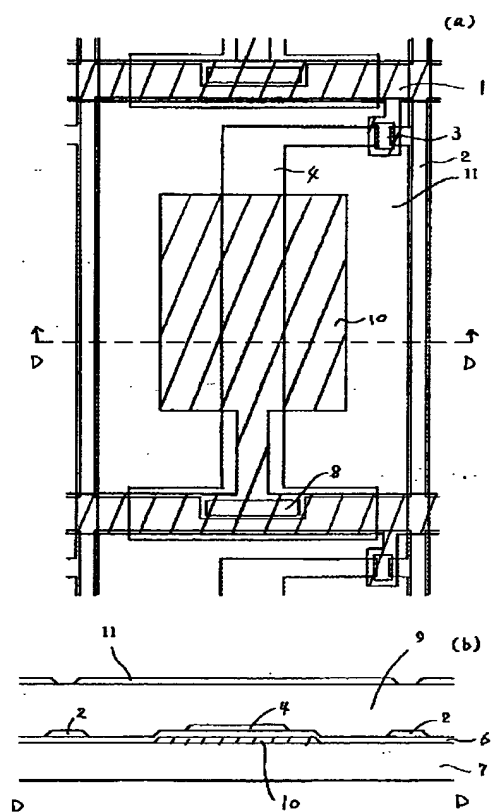


【図4】

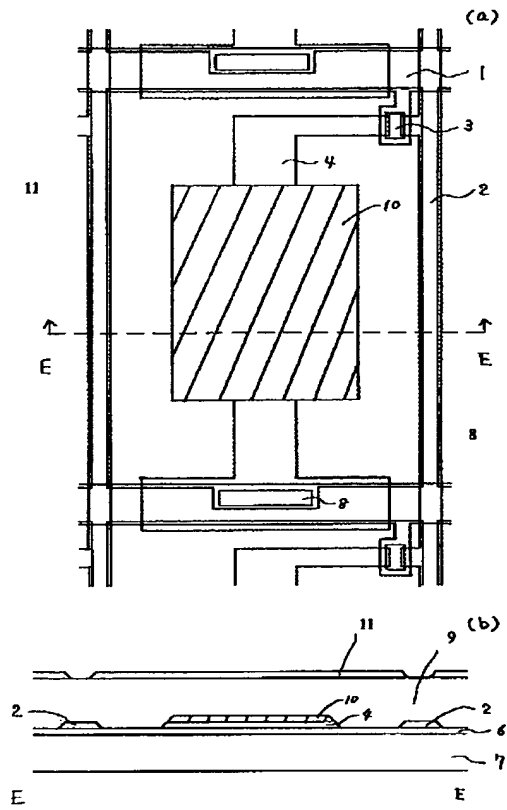
【図5】



【図6】



【図7】



【図8】

